

NPNエピタキシャル形シリコン複合トランジスタ
差動増幅用
通信工業用

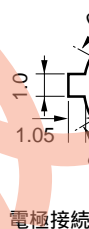
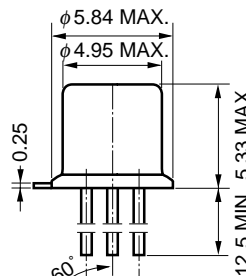
外形図 (単位 : mm)

2SC1733は、2SC1275のデュアルトランジスタです。

The 2SC1733 is a dual transistor of the 2SC1275.

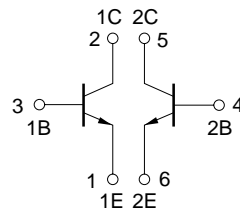
$f_r = 2.0$ GHz TYP.

TO-18と同じ大きさの小型ケースを使用。



電極接続

- 1. 1E
- 2. 1C
- 3. 1B
- 4. 2B
- 5. 2C
- 6. 2E



絶対最大定格 (TA = 25)

項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	30	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	14	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EB0}	3.0	V
コレクタ電流	I _c	50	mA
コレクタ損失	P _c	200	mW/unit
全損失	P _T	300	mW
ジャンクション温度	T _j	200	
保存温度	T _{stg}	- 65 ~ + 200	

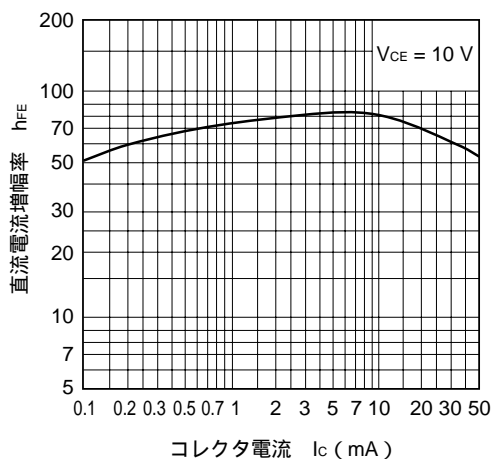
電気的特性 (TA = 25)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタしゃ断電流	I _{CEs}	V _{CE} = 15 V, R _{BE} = 0			50	nA
エミッタしゃ断電流	I _{EB0}	V _{EB} = 2.0 V, I _c = 0			50	nA
直流電流増幅率	h _{FE}	V _{CE} = 10 V, I _c = 10 mA	25	80	200	
直流電流増幅率比	h _{FE1} /h _{FE2}	V _{CE} = 10 V, I _c = 10 mA ^注	0.8		1.0	
ベース・エミッタ電圧差	V _{BE}	V _{CE} = 10 V, I _c = 10 mA			30	mV
利得帯域幅積	f _T	V _{CE} = 10 V, I _c = 10 mA	1.5	2.0		GHz
コレクタ容量	C _{ob}	V _{CB} = 10 V, I _E = 0, f = 1.0 MHz		1.1	1.5	pF

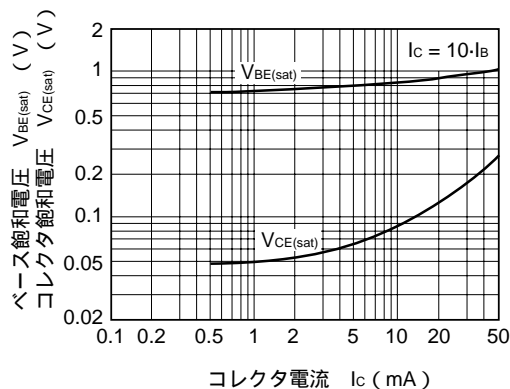
注 h_{FE}の小さい方をh_{FE1}とする。

特性曲線 (TA = 25)

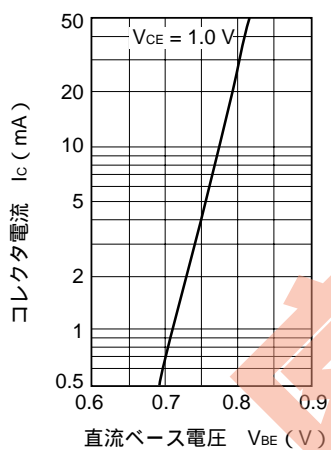
直流電流増幅率 vs. コレクタ電流



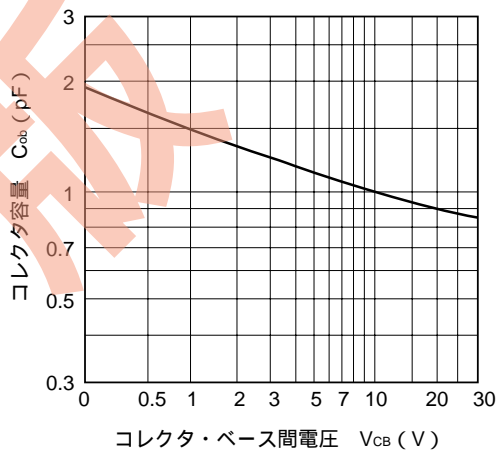
ベース飽和電圧, コレクタ飽和電圧 vs. コレクタ電流



コレクタ電流 vs. 直流ベース電圧



コレクタ容量 vs. コレクタ・ベース間電圧



利得帯域幅積 vs. コレクタ電流

